

Кремниевый фотодетекторный чип 762×762 мкм — техническое описание

P/N : WS9J-01A

Применение

Si PIN фотодиодные чипы.

Структура

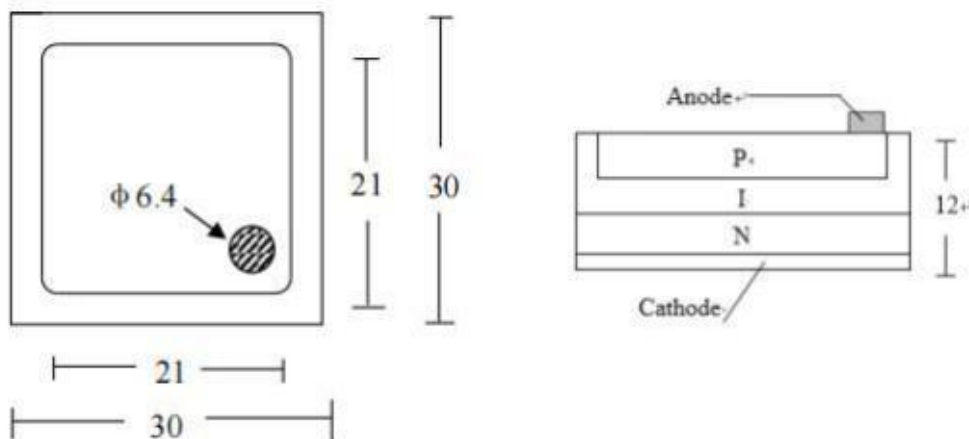
Планарная структура: PIN-диод; электроды: верхняя сторона (катод) — Al, задняя сторона (анод) — сплав Au

ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	21 × 21 (± 1.0)			мил
Ширина чипа	30 × 30 (± 1.5)			мил
Длина чипа	30 × 30 (± 1.5)			мил
Высота чипа	12 (± 1.0)			мил
Контактная площадка катода	6.4 × 6.4			мил
Контактная площадка анода	6.4 × 6.4			мил

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	VF	IF=10mA, H=0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	VBR	IR=100μA, H=0	35			В
Обратный темновой ток	ID	VR=10V, H=0			10	нА
Рабочий диапазон длин волн	λр			940		нм
Емкость	CJ	VR=3V, F=1 MHz		9		пФ



Ед.: мил